

三相ブリッジダイオード
3 Phase Bridge Diode

大容量 シングルインライン型
Large I_o Single In-line Package

D45XT80

800V 45A

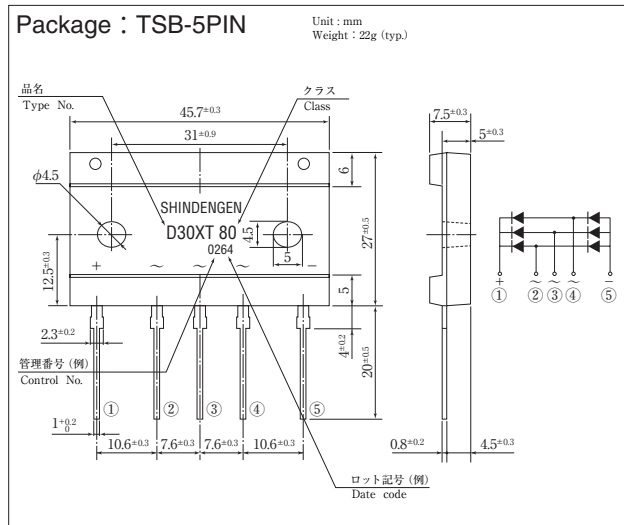
特長

- 小型3相ブリッジ
- 薄型SIPパッケージ
- UL E142422
- 高放熱伝導性

Feature

- 3Phase-Bridge
- Thin-SIP
- UL E142422
- High Thermal Radiation

外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



(製品上の表示については、捺印仕様をご確認ください)

定格表 RATINGS

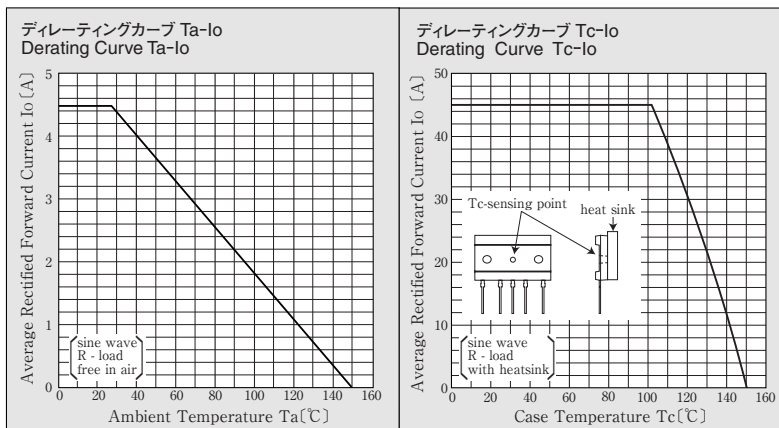
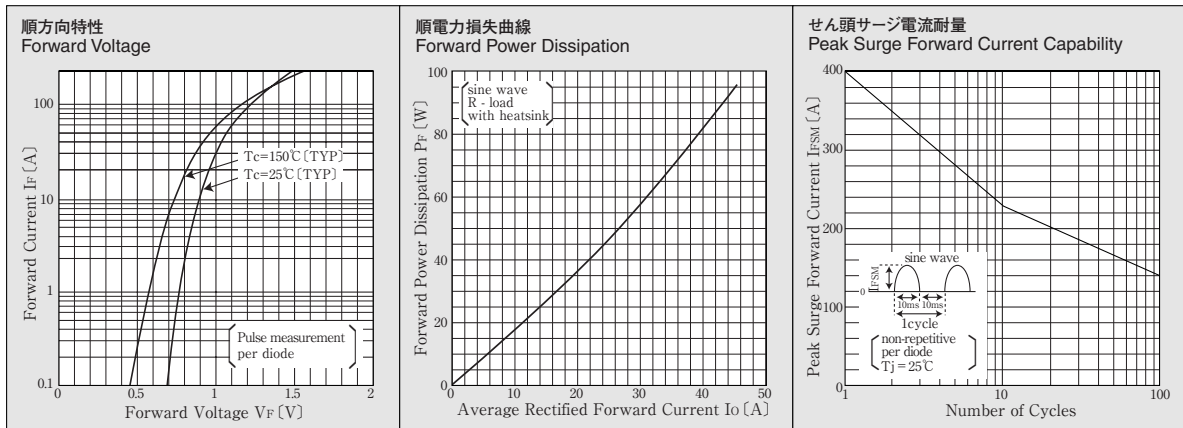
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合は T_c = 25°C / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D45XT80	単位 Unit	
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}			-40~150	°C	
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			150	°C	
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			800	V	
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	フィン付き With heatsink	T _c =101°C	45.0	A
			フィンなし Without heatsink	T _a =27°C	4.5	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T _j =25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, T _j =25°C		400	A	
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	1ms ≤ t < 10ms		800	A ² s	
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V _{dis}	一括端子・ケース間, AC 1分間印加 モールド部上面 (端子と平行面) は除く Terminals to Case, AC 1 minute. Except top (opposite side of the terminal side) of the mold case.		2.5	kV	
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 1.2 N·m) (Recommended torque: 1.2 N·m)		1.5	N·m	

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合は T_c = 25°C / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F =15A, パルス測定, 一素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R =800V, パルス測定, 一素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to Case	MAX 0.5	°C/W
	θ _{ja}	接合部・周囲間 Junction to Ambient	MAX 16	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- ・ Sine waveは50Hzで測定しています。
- ・ 50Hz sine wave is used for measurements.
- ・ 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。Typicalは統計的な実力を表しています。
- ・ Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.